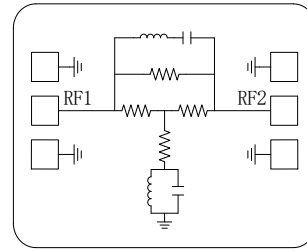


### 特点:

- 输入范围: 0.1~2.0GHz
- 插入损耗: 0.5dB@2GHz
- 均衡量: 3dB
- 端口回波损耗: 23dB
- 芯片尺寸: 0.75mm×0.8mm×0.1mm

### 功能框图:



### 产品简介:

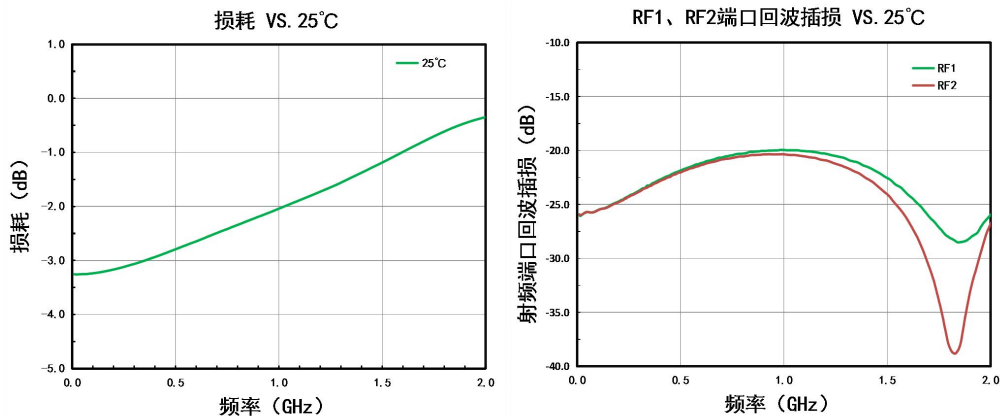
YDC8212 是一款采用 GaAs pHEMT 工艺设计制造的均衡器。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理, 适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

### 性能参数: (50Ω系统, T<sub>A</sub>=+25°C)

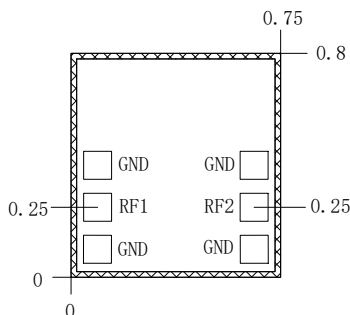
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	Pin: 0dBm f: 0.1GHz~2.0GHz	0.1	-	2.0	GHz	-
插入损耗	IL		-	0.5	-	dB	2GHz
均衡量	ΔLi		-	3.0	-	dB	-
输入/出回波损耗	RL		-	23/25	-	dB	-

\*: 芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

### 典型测试曲线: (50Ω系统, T<sub>A</sub>=+25°C)



### 外形尺寸图:



注: 1. 单位: mm;

2. 芯片背面镀金, 背面接地;
3. 外形尺寸公差: ±0.05mm;
4. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm×0.1mm。

### 引脚定义:

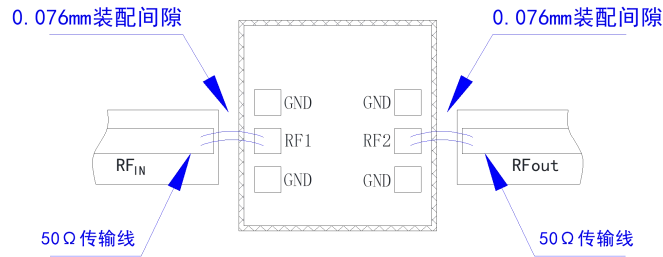
符号	描述
RF1	射频端口, 内部无隔直
RF2	射频端口, 内部无隔直
GND/芯片背面	接地, 芯片底部需接地良好

### 极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率.50Ω	+27dBm
装配温度	+300°C, 20s
工作温度	-55°C~+85°C
贮存温度	-55°C~+150°C

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。



**推荐装配图：**

注：射频端口应尽量靠近微带线以缩短键合金丝尺寸，典型的装配间隙是 0.076~0.152mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ 。

**产品使用注意事项：**

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用。
2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面，使用时须小心。
3. 芯片粘结装配时，需考虑热膨胀应力对芯片的影响，芯片建议烧结或粘结在热膨胀系数相近的载体上，如可伐、钨铜或钼铜垫片上，避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
4. 芯片使用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过+300 $^{\circ}\text{C}$ ，时间不能超过 20 秒），使之充分接地。
5. 芯片射频端口使用 25 $\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 0.25~0.40mm（10~16 mils）。
6. 在存储和使用过程中注意防静电，烧结、键合台接地良好。